



美光推出 256GB DDR5 伺服器模組樣品 重新定義 AI 效能

採用 1-gamma DRAM 與先進封裝技術，提供業界最快速效能

愛達荷州博伊西，2026 年 5 月 14 日 — 美光科技 (Nasdaq: MU) 今日宣布，已向主要伺服器生態系合作夥伴提供 256GB DDR5 具暫存器雙列直插式記憶體模組 (RDIMM) 樣品。該模組採用業界領先的 1-gamma 製程技術，最高速度可達每秒 9,200 百萬次傳輸 (MT/s)，較目前量產中的模組快了 40% 以上。¹

此款模組採用先進封裝技術，結合 3D 堆疊 (3DS) 與矽穿孔 (TSV) 技術，將多顆記憶體晶粒整合於單一模組中。搭配美光 1-gamma DRAM，這些創新可提供支援下一代 AI 系統所需的容量、速度與能源效率。一條 256GB 模組相較於兩條 128GB 模組，可降低超過 40% 的運行功耗，進一步提升現代 AI 資料中心的整體效率。²

生態系合作夥伴驗證

美光正與多家關鍵生態系合作夥伴合作，針對 256GB 1-gamma DDR5 RDIMM 於現有與次世代伺服器平台進行驗證。此共同驗證可確保其在各類平台上的廣泛相容性，並加速導入大量部署，協助資料中心客戶建置 AI 與高效能運算 (HPC) 基礎設施。

美光科技資深副總裁暨雲端記憶體事業部總經理 Raj Narasimhan 表示，容量、頻寬與功耗是決定 AI 效率的關鍵要素。透過我們的 256GB DDR5 RDIMM，美光正協助伺服器實現顯著的效能提升。此產品基於 1-gamma DRAM，並結合先進 3DS 與 TSV 封裝技術，提供業界領先的速度與能源效率，幫助資料中心架構師能更有效率地擴展 AI 基礎設施。

滿足 AI 時代的記憶體需求

¹ 效能優勢是以 9,200 MT/s 相比 6,400 MT/s 產品所計算得出。

² 功耗以瓦特 (W) 為單位測量。計算方式為比較兩條 128GB 模組 (各為 9.7 W，合計 19.4 W) 與單條 256GB 模組 (11.1 W)。

隨著大型語言模型 (LLM)、代理型 AI (agentic AI)、即時推論以及高核心數 CPU 工作負載快速發展，企業伺服器對於更高記憶體容量、更大頻寬與更佳能源效率的需求日益迫切。美光 256GB DDR5 RDIMM 正是針對這些需求設計，讓伺服器架構師、雲端營運商與平台合作夥伴能在既有的散熱與功耗限制下，最大化每個處理器插槽的記憶體容量。

樣品與供應資訊

美光採用 1-gamma 製程的 256GB DDR5 RDIMM 目前已提供給主要伺服器生態系合作夥伴進行平台驗證。欲了解更多美光資料中心解決方案，請參閱官方網站 [Micron data center memory webpage](#)。

關於 Micron Technology, Inc.

我們是創新記憶體和儲存空間解決方案的業界領導者，致力於改變世界使用資訊的方式，豐富所有人的生活樣貌。美光持續專注於用戶需求、技術領先、卓越的製造與營運，提供高效能 DRAM、NAND 及 NOR 記憶體與儲存產品的完整組合，每一天，我們人員提出的創新推動了數據經濟的發展，促成人工智慧 (AI) 和計算密集型應用的進步，並激發從資料中心、智慧邊緣到用戶端與行動裝置的多元機會與使用者體驗。欲進一步瞭解 Micron Technology, Inc. (Nasdaq : MU)，請瀏覽 [tw.micron.com](#)。

© 2026 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊、產品及 / 或規格若有變更，恕不另行通知。美光、美光標誌及其他所有美光商標均為 Micron Technology, Inc. 所有。所有其他商標皆屬其各自擁有者所有。

美光產品與技術溝通聯絡人：

Mengxi Liu Evensen
+1 (408) 444-2276
productandtechnology@micron.com

美光投資人關係聯絡人：

Satya Kumar
+1 (408) 450-6199
satyakumar@micron.com